

Total No. of Printed Pages—8

6 SEM TDC PHY G 1

2 0 1 4

(May)

PHYSICS

(General)

Course : 601

(Electronics and Solid State Physics)

Full Marks : 56

Pass Marks : 22

Time : 2½ hours

The figures in the margin indicate full marks
for the questions

1. শুন্ধ উত্তরটো বাটি উলিওৱা : $1 \times 6 = 6$

Choose the correct option :

(a) জুল এককত জামেনিয়াম স্ফটিকৰ নিষিদ্ধ শক্তি অন্তবালৰ
মান হ'ল

For germanium crystal, the forbidden
energy gap in joules is

(i) 1.12×10^{-19}

(ii) 1.76×10^{-19}

(iii) 1.6×10^{-19}

(iv) 0.7×10^{-19}

(b) অর্ধ-তরঙ্গ সংবিশক ক্ষেত্রত তরঙ্গটোৰ পৰিৱৰ্তী প্ৰাহ
উপাঞ্চৰ r.m.s. মান

In a half-wave rectifier, the r.m.s. value
of the a.c. component of the wave is

- (i) একমুখী প্ৰাহৰ মানৰ সমান
equal to d.c. value
- (ii) একমুখী প্ৰাহৰ মানতকৈ বেছি
more than d.c. value
- (iii) একমুখী প্ৰাহৰ মানতকৈ কম
less than d.c. value
- (iv) শূন্য
zero

(c) কোনটো সজ্জা ব্যৱহাৰ কৰিলে ট্ৰেনজিস্টোৰ এটাই সুদৰ
শক্তি সংবৰ্ধন দেখুৱায় ?

The transistor provides good power
amplification when they are used in

- (i) কমন কলেক্টোৰ সজ্জা
common collector configuration
- (ii) কমন এমিটাৰ সজ্জা
common emitter configuration
- (iii) কমন বেচ সজ্জা
common base configuration
- (iv) ওপৰৰ এটাও নহয়
None of the above

(3)

(d) এক বিশেষ স্ফটিক প্রণালীৰ জালিকা প্রাচলসমূহ হ'ল

একক কোষৰ অক্ষসমূহ : $a = b \neq c$

অক্ষসমূহৰ ঘাজৰ কোণ : $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

তেন্তে স্ফটিক প্রণালীটো হ'ল

A particular crystal system has the following lattice parameters :

Unit cell axes : $a = b \neq c$

Angle between axes : $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

Then the crystal system will be

(i) ট্ৰাইলিনিক

triclinic

(ii) অৰ্থ'ৰ'ম্বিক

orthorhombic

(iii) টেট্ৰাগ'নেল

tetragonal

(iv) কিউবিক

cubic

(e) 0 K উপরাত মুক্ত ইলেক্ট্ৰন গেছ এবিধৰ গড় গতিশক্তি হ'ল

The average kinetic energy of a free electron gas at 0 K is

(i) $\frac{3}{5} E_F$

(ii) $\frac{5}{2} E_F$

(iii) $\frac{3}{2} E_F$

(iv) 0

য'ত E_F হ'ল ফাৰ্মি শক্তি।

where E_F is Fermi energy.

(f) কঠিন অরহাব পদাৰ্থ এটাত ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰ্যকৰী ভ্ৰ হ'ল²
 The effective mass of the electron in
 a solid is given by

$$(i) \frac{\hbar^2}{\left(\frac{d^2k}{dE^2}\right)}$$

$$(ii) \frac{\hbar^2}{\left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)}$$

$$(iii) \frac{\left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)}{\hbar^2}$$

$$(iv) \frac{\left(\frac{d^2k}{dE^2}\right)}{\hbar^2}$$

2. তলত দিয়া ষি কোনো ছটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা : $2 \times 6 = 12$

Answer any six questions from the following :

(a) বিশুদ্ধ অৰ্ধ-পৰিবাহী এটাত আভ্যন্তৰিক গাঢ়তাৰ সৈতে
 হ'ল গাঢ়তা আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ গাঢ়তাৰ সম্পর্ক কোন ?

How are hole concentration and electron
 concentration related to the intrinsic
 concentration in pure semiconductors?

(b) संदिशन कि ? अर्ध-तरंग संदिशक एटार गड़ आउटपुट विभव व मान किमान ?

What is rectification? What is the average output voltage of a half-wave rectifier?

(c) α आरु β व माजब सम्पर्क ब्यूंपादन करा।

Derive a relationship between α and β .

(d) स्पन्दनब वाबे वार्कहाउचेन चर्त कि ?

What is Barkhausen criterion for oscillation?

(e) फार्मि लेवल कि ?

What is Fermi level?

(f) फार्मि शक्तिव मान 8 eV ह'ले 0 K उक्तात इलेक्ट्रन एटार गड़ शक्तिव इयाब बेग किमान ह'व ?

Calculate the speed of electron at its mean energy at 0 K, if the Fermi energy is 8 eV.

(g) स्फटिक एटात कोनो एक तले स्फटिकीय अक्षसमृहक $2a$, $3b$ आरु c दूरत्वत हेद कविछे। तलखनब मिलाब संसूचकसमृह निर्णय करा।

In a crystal, a plane cuts intercepts $2a$, $3b$ and c along the crystallographic axes. Determine the Miller indices of the plane.

3. (a) ବ୍ରେକଡ଼ାଉନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାବସମୂହ କି କି? ଇହିତର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ କାର୍ଯ୍ୟପରିଣାମି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ।

4

What are the different types of breakdown? Explain the mechanism of each of them.

(b) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ତବ୍ରଗ ସଂଦିଶକ ଏଟାର କ୍ଷେତ୍ରତ ଦେଖୁଓରା ଯେ r.m.s. ପ୍ରବାହର ମାନ I' ଲ $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$, ଯ'ତ I_0 I' ଲ ପ୍ରବାହର ଶୀଘ୍ର ମାନ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ତବ୍ରଗ ସଂଦିଶକର ବାବେ $I_{d.c.}$ ର ମାନ କିମାନ I' ବ ?

3+2=5

Show that in a full-wave rectifier, the r.m.s. current is $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$, where I_0 is the peak value. What is the value of $I_{d.c.}$ for a full-wave rectifier?

ଅଥବା / Or

ଦେଖୁଓରା ଯେ ଚିଲିକନ ପରିବାହି ଏଟାର କ୍ଷେତ୍ରତ ମୁଠ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରବାହର ମାନ I' ଲ $J = q(p\mu_h + n\mu_e)E$, ଯ'ତ q = ବାହକ ଏଟାର ଆଧାନ, μ_h = ହଲର ଚଚଳତା, μ_e = ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚଚଳତା, p = ହଲର ସଂଖ୍ୟା, n = ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂଖ୍ୟା, E = ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ର ।

5

Show that the total drift current in a silicon conductor is $J = q(p\mu_h + n\mu_e)E$, where q = charge on a carrier, μ_h = mobility of holes, μ_e = mobility of electrons, p = number of holes, n = number of electrons, E = electric field.

- (c) সঠিক বর্তনী চিত্রের সহায়ত এটা ফেজ-শিফ্ট দোলকের
স্পন্দন কম্পনাংকের প্রকাশবাণি উলিওরা।

6

Obtain an expression for the frequency
of oscillation with proper circuit
diagram of a phase-shift oscillator.

- (d) ট্রানজিস্টাৰ সংবৰ্ধক এটাৰ সংকাৰক বিন্দু কি? সংকাৰক
বিন্দু কেনেকৈ নিৰ্গত কৰিব পাৰি?

2+2=4

What is operating point of a transistor
amplifier? How one can choose the
operating point?

4. (a) কিউবিক জালিকা এখনৰ ক্ষেত্ৰত জালিকা বিন্দুৰ সংখ্যাৰ
প্রকাশবাণি উলিওৱা।

3

Obtain an expression for the number
of lattice points in a cubic lattice.

- (b) সৰল কিউবিক, বডি চেন্টার্ড কিউবিক আৰু ফেচ চেন্টার্ড
কিউবিক জালিকাৰ বাবে পাৰমাণবিক পেকিঙ ফ্ৰেকচন
গণনা কৰা।

2+2+2=6

Calculate the atomic packing fraction
for simple cubic, body-centred cubic
and face-centred cubic lattice.

অথবা /Or

- ব্ৰেগৰ নীতি কি? ব্ৰেগৰ X-বশি বৰ্ণনীমাপন যন্ত্ৰ এটাৰ
কাৰ্যপ্ৰণালী চয়কৈ বৰ্ণনা কৰা।

2+4=6

What is Bragg's law? Describe briefly
the working of a Bragg's X-ray
spectrometer.

(c) মেইজনার প্রভাব কি ? Type-I আৰু Type-II অতি-
পৰিবাৰ্হীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বুজাই লিখা। $2+3=5$

What is Meissner effect? Distinguish
between Type-I and Type-II super-
conductors.

(d) ধাতু এবিধৰ তাপীয় পৰিবাৰ্হিতা কি ? বিদ্যুৎ পৰিবাৰ্হিতাৰ
লগত ইয়াৰ সম্পর্ক কি ? $3+2=5$

What is thermal conductivity of a metal?
How is it related to the electrical
conductivity?

